【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成29年12月28日(2017.12.28)

【公表番号】特表2016-541115(P2016-541115A)
【公表日】平成28年12月28日(2016.12.28)
【年通号数】公開・登録公報2016-070
【出願番号】特願2016-527257(P2016-527257)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　21/301　(2006.01)
Ｂ２３Ｋ　26/53　(2014.01)
Ｂ２３Ｋ　26/364　(2014.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　21/78　Ｂ
Ｂ２３Ｋ　26/53
Ｂ２３Ｋ　26/364

【手続補正書】
【提出日】平成29年11月16日(2017.11.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
成長基板と、該成長基板の上に形成されたデバイスとを含むウェハーを分離するための方法であって、
前記ウェハーの前側から、第１のスクライブラインをアブレーションスクライビングするステップであり、前記ウェハー内の２列のデバイスを分離するストリートに前記第１のスクライブラインが整合する、ステップ、
前記ウェハーの後側から、前記ストリートに整合する第２のスクライブラインをステルススクライビングするステップ、
前記後側から、前記第２のスクライブラインよりも浅い深さの場所に、前記ストリートに整合する第３のスクライブラインをアブレーションスクライビング又はステルススクライビングするステップ、
を含む方法。
【請求項２】
前記第１のスクライブラインは、前記成長基板の上にエピタキシャル成長した材料の厚さを貫通して前記成長基板内に延びる深さであり、
前記成長基板内に延びる前記深さは、少なくとも、前記成長基板の上にエピタキシャル成長した前記材料の厚さである、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記第１のスクライブラインは、前記成長基板の上にエピタキシャル成長した材料の厚さを貫通して前記成長基板内に延びる深さであり、
前記成長基板内に延びる前記深さは、前記成長基板の上にエピタキシャル成長した前記材料の厚さの３倍以下である、
請求項１に記載の方法。
【請求項４】

前記成長基板は２００ミクロンよりも大きな厚さを有する、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
前記ストリートは、５０ミクロン未満の幅を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
前記後側で、前記ストリートに整合した第４のスクライブラインをスクライビングするステップであり、前記第４のスクライブラインは、前記成長基板内において前記第２及び第３のスクライブラインとは異なる深さにある、
請求項１に記載の方法。
【請求項７】
前記成長基板が１００ミクロンを超える厚さを有する、
請求項１に記載の方法。